

高性能 α -Ga₂O₃パワー半導体の低コスト量産化実証（株式会社FLOSFIA）



所在地	創設年	創設者名	ホームページ
京都府京都市	2011年	人羅 俊実	https://flosfia.com

パートナーVC	直近の資金調達ラウンド	企業価値
—	シリーズE	14,500百万円

会社連絡先：

tel: 075-963-5202

e-mail: info@flosfia.com

ホームページリンク: <https://flosfia.com>

○事業概要

パワー半導体用途に特化して優れた性能を発揮する新素材 α -Ga₂O₃（コランダム構造酸化ガリウム）を用いてパワー半導体の高性能・低コスト化技術を開発し、高性能と低コストの両立を達成する量産技術の確立や社会実装を実現することにより、電気自動車やロボット、電源、インバーターなど、多岐に渡る事業分野における電力変換ロスを削減し、市場規模の拡大を目指す。

○事業内容

本研究開発では、新素材 α -Ga₂O₃を用いたパワー半導体の高性能・低コスト化技術を開発し、デバイス構造・プロセスの最適化、信頼性評価、顧客フィードバック等による課題解決を図る。

下記に掲げる開発項目を達成することで、「高性能」・「低コスト」の重要な水準のクリアを目指す。

- ①小チップサイズのデバイス設計開発
- ②低コストプロセス設計開発
- ③ウエハの大口径化
- ④チップの小型化
- ⑤信頼性の確保

事業領域・分野	助成事業年度	交付決定額	海外技術実証
素材・材料	DMP 2023～2025年度	300百万円	—

○海外技術実証

予定なし